

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2002年6月13日 (13.06.2002)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 02/47142 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/31
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/10594
- (22) 国際出願日: 2001年12月4日 (04.12.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2000-370023 2000年12月5日 (05.12.2000) JP  
特願2001-26233 2001年2月2日 (02.02.2001) JP

[JP/JP]: 〒407-0174 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロン東北株式会社 穂坂事業所内 Yamanashi (JP). 林 輝幸 (HAYASHI, Teruyuki) [JP/JP]. 斉藤美佐子 (SAITO, Misako) [JP/JP]: 〒407-0174 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650番地 東京エレクトロン株式会社内 Yamanashi (JP). 佐藤昌一 (SATO, Syoichi) [JP/JP]: 〒194-0012 東京都町田市金森1259 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 吉武夏次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

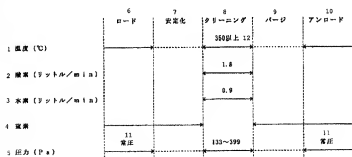
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菱屋晋吾 (HISHIYA, Shingo) [JP/JP]. 古澤純和 (FURUSAWA, Yoshikazu) [JP/JP]. 梅澤好太 (UMEZAWA, Kota)

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR TREATING ARTICLE TO BE TREATED

(54) 発明の名称: 被処理体の処理方法および処理装置



- 1...TEMPERATURE (°C)  
2...OXYGEN (LITER/LMIN)  
3...HYDROGEN (LITER/LMIN)  
4...HYDROGEN (LITER/LMIN)  
5...PRESSURE (Pa)  
6...LOADING  
7...STABILIZATION  
8...CLEANING  
9...PURGING  
10...UNLOADING  
11...ORDINARY PRESSURE  
12...310 OR HIGHER

(57) Abstract: An apparatus (1) for treating a wafer, which has a heater (12), a reaction tube (2) for storing a wafer (10) having an organic material adhered thereto and, a first gas conduit (13) and a second gas conduit (14) for feeding an oxygen gas and a hydrogen gas, respectively, into the reaction tube (2); and a method for treating a wafer to be treated, which comprises feeding an oxygen gas and a hydrogen gas through the first gas conduit (13) and the second gas conduit (14), respectively, into the reaction tube (2), and heating the reaction tube (2) by the heater (12) to a temperature sufficient for activating the oxygen gas and hydrogen gas, to thereby allow a combustion reaction to take place and oxidize, decompose and remove the organic material adhered to the wafer (10).

[続表有]

B8

WO 02/47142 A1